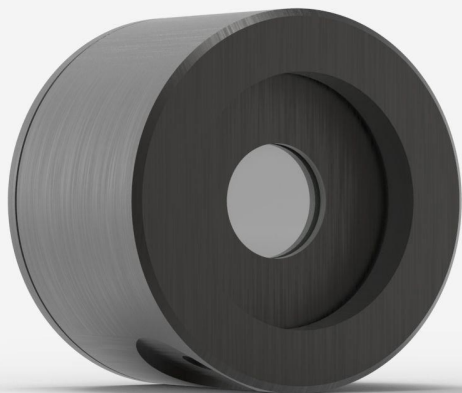


PH100-SI-HA-DO

Fotodioden-Detektor zur Laserleistungsmessung bis zu 36 mW.



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

GROSSE APERTUREN

10 mm Ø für die Siliziumsensoren

3 VERSIONEN

- Silizium 350 - 1080 nm, bis 750 mW
- Silizium-UV 210 - 1080 nm, bis 38 mW
- Germanium 800 - 1650 nm, bis 500 mW

WAHL DER ABSCHWÄCHER

- OD0.3: 50% Transmission (PH100-Si^{UV})
- OD1: 10% Transmission
- OD2: 1% Transmission

HOHE MESSGENAUIGKEIT

Der neue PH100-Si-HA hat eine geringere Kalibrierunsicherheit

PRÄZISE KALIBRIERUNG

Auswahl der Wellenlänge in 1 nm-Schritten

INTELLIGENTE BENUTZEROBERFLÄCHE

Enthält alle Kalibrierungsdaten

KOMPATIBLER STÄNDER

[STAND-D-233](#)



SPEZIFIKATIONEN

MESSMÖGLICHKEITEN

Maximale Durchschnittsleistung ¹	36 mW
Äquivalente Rauschleistung ²	10 pW
Spektralbereich	350 - 1080 nm
Typische Anstiegszeit	0.2 s
Unsicherheit der Leistungskalibrierung	±5.0 % (350 - 399 nm) ±2.0 % (400 - 449 nm) ±1.5 % (450 - 809 nm) ±2.0 % (810 - 899 nm) ±4.0 % (900 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm)
Spitzenempfindlichkeit	0.5 A/W @ 980 nm
Minimale Wiederholungsrate ³	155 kHz

1. Bei 1064 nm, mit Abschwächer. Siehe Kurven für die maximale Leistung bei anderen Wellenlängen.

2. Bei 980 nm. Nennwert. Der Istwert hängt von der elektromagnetischen Interferenz der Umgebung und der Wellenlänge ab.

3. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

ZERSTÖRSCHWELLE

Maximale durchschnittliche Leistungsdichte	100 W/cm ²
--	-----------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Apertur-Durchmesser	10 mm
Absorber	Si
Abmessungen	38.1Ø x 27.4D mm
Gewicht	0,13 kg
Abstand zur Sensorfläche	13,7 mm

BESTELLINFORMATIONEN

PH100-Si-HA-D0

202681

PH100-Si-HA-IDR-D0

203219

PH100-Si-HA-INT-D0

202782

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns